PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-182780

(43) Date of publication of application: 02.07.2004

(51)Int.Cl.

CO9K 11/59

CO9K 11/08

CO9K 11/65

CO9K 11/66

CO9K 11/80

H01L 33/00

(21)Application number: 2002-348386

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

TAMAOKI HIROTO

(22)Date of filing:

29.11.2002

(72)Inventor:

KAMESHIMA MASATOSHI

TAKASHIMA MASARU

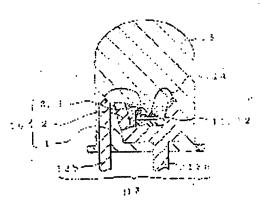
(54) NITRIDE PHOSPHOR AND LIGHT-EMITTING EQUIPMENT USING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-emitting equipment which emits white light of a slightly reddish warm color type with good luminous efficiency, and a phosphor which has an emission spectrum in the yellow to red region and is used in combination with a blue light-emitting device or the like.

SOLUTION: The light-emitting equipment has a blue light-emitting device 10 and a nitride phosphor which converts the wavelength in part of a first light-emitting spectrum excited by the light-emitting device 10 to have a second light-emitting spectrum in the yellow to red region, is added with at least one of elements including Na, K, Rb, Mg, B, Al, Ga, Ti, Zr and the like, and is represented by the formula: LXMYN((2/3)X+(4/3)Y):Eu or LXMYOZN((2/3)X+(4/3)Y-(2/3)Z):Eu (wherein L is Ca or

Sr; M is an essential element of Si; and N is nitrogen).



(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2004-182780 (P2004-182780A)

(43) 公開日 平成16年7月2日(2004.7.2)

			(10)	A 14 H	1 140 10-1-112	
(51) Int. Cl. ⁷	Fi				テーマコー	ド(参考)
CO9K 11/59	CO9K	11/59	CQH		4H001	
CO9K 11/08	СОЭК	11/08	В		5FO41	
CO9K 11/65	соэк	11/08	С			
CO9K 11/66	CO9K	11/08	D			
CO9K 11/80	CO9K	11/08	J			
			青末項の数 16	OL	(全 32 頁)	最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2002-348386 (P2002-348386)	(71) 出	願人 000226	057		
(22) 出願日	平成14年11月29日(2002.11.29)		日亜化	学工業材	朱式会社	
• •			徳島県	阿南市」	上中町岡49]	l番地100
		(72) 発	明者 玉置	寬人		
			徳島県	南南市。	上中町岡491	1番地100
		ļ	日亜化	学工業権	株式会社内	
		(72) 発	明者 亀島	正敏		
			徳島県	阿南市	上中町岡491	[番地100
			日亜化	学工業	株式会社内	
		(72) 発	明者 高島	優		
		` /		阿南市	上中町岡491	1番地100
			日亜化	学工業権	株式会社内	
					ŧ	最終百に待く

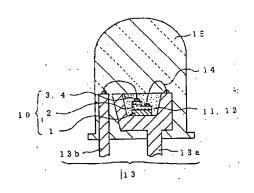
(54) 【発明の名称】窒化物蛍光体及びそれを用いた発光装置

(57)【要約】

【課題】発光効率の良好なやや赤みを帯びた暖色系の白色発光装置を提供すること、 青色発光素子等と組み合わせて使用する黄から赤領域に発光スペクトルを有する蛍光体を提供することを目的とする。

【解決手段】青色に発光する発光素子10と、該発光素子10により励起された第1の発光スペクトルの一部を波長変換し、黄から赤色領域に第2の発光スペクトルを有する、Na、K、Rb、Mか、B、Al、Ga、Ti、Zr等の元素が一種以上添加された、一般式 L_X M_Y $N((2/3) x + (4/3) y) : Eu若しくは<math>L_X$ M_Y O_Z N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x + (4/3) x

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

500nm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780nmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する、一般式しx My N((2/3) x + (4/3) y) : R若しくはしx My Ox N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x) : R (しは、M3 x Cax Sh Bax Zn からなる第11族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。 Mは、Sh Si、GeのうちSiを必須とする第1V族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。 Mは、F C t C C C C Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er t L u のうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)で表される窒化物蛍光体であって、

前記室化物蛍光体は、前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素が含有されていることを特徴とする室化物蛍光体。

【請求項2】

500nm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780nmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する、一般式しx My N((2/3) x + (4/3) y) : R 若しくはしx My Ox N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x) : R (しは、M3、Ca、 Sh Ba、 Zn からなる第11族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。Mは、C 、 Si、GeのうちSiを必須とする第1V族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)で表すれる窒化物蛍光体であって、

前記室化物蛍光体の原料中には、前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素が含有されていることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項3】

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、し i 、 N の、K 、 R b 、 C S からなる第 I 族元素から選ばれる少なくとも 1 種以上の元素であることを特徴とする 1 又は 2 の i) ずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項4】

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、Cu、A分、Auからなる第 「族元素、B、AI、Ga、Inからなる第III族元素、Ti、区グ、Hf、Sn、Pbからなる第IV族元素、P、Sb、Biからなる第V族元素、Sからなる第VI族元素 から選ばれる少なくとも1種以上の元素であることを特徴とする請求項1又は2のいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項5】

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、V、Nb、Tのからなる第V族元素、Cr、Mo、Wからなる第VI族元素、Reからなる第VIII族元素、Fe、Co、Ir、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第VIII族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素であることを特徴とする請求項1又は2のいずれか一項に記載の窒化物蛍光体。

【請求項6】

 10

20

30

40

で表される窒化物蛍光体であって、

前記し、前記Mの少なくとも1種以上の元素が、1000PPm以下含有されていることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項7】

500nm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780nmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する、一般式しx My N((2/3) x + (4/3) y) : R 若しくはしx My Ox N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x) : R (しは、M3、Ca、 Sr Ba、 Zn からなる第11族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。 Mは、C S に、GeのうちSiを必須とする第1V族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。 Rは、Y、しa、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er しいのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)で表すれる窒化物蛍光体であって、

前記室化物蛍光体の原料中には、前記し、前記Mの少なくとも1種以上の元素が、1000PPm以下含有されていることを特徴とする室化物蛍光体。

【請求項8】

前記室化物蛍光体は、還元雰囲気中で焼成されていることを特徴とする請求項1乃至7の少なくともいずれか一項に記載の室化物蛍光体。

【請求項9】

Rの酸化物(Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)と、Li、Na、K、Rb、CS、Cu、Aタ、Auからなる第 I 族元素、B、Aー、Ga、Inからなる第 I I I 族元素、Ti、 Ξ r、Hf、Sn、Pbからなる第 I V 族元素、V、Nb、Ta、P、Sb、Biからなる第 V 族元素、Cr、Mo、W、Sからなる第 V I 技元素、Reからなる第 V I I I 族元素、Fe、Co、I r、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第 V I I I 族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素が含有されている化合物と、を湿式混合する第 1 の I 程と、

第1の工程より得られる混合物を焼成する第2の工程と、

第2の工程で得られる混合物と、しの窒化物(しは、M3、Ca、Sr、Ba、Znからなる第II族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)と、Mの窒化物及びMの酸化物(Mは、C、Si、GeのうちSiを必須とする第IV族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)の少なくともいずれか1つと、を混合する第3の工程と、

第3の工程より得られる混合物を還元雰囲気中で焼成する第4の工程と、

を少なくとも有する窒化物蛍光体の製造方法。

【請求項10】

前記第2の工程、及び、前記第4の工程の少なくとも一方は、Li、Nの、K、Rb、CS、Cu、A9、Auからなる第I族元素、B、AI、Gの、Inからなる第III族元素、Ti、区 r、Hf、Sn、Pbからなる第IV族元素、V、Nb、Tの、P、Sb、Biからなる第V族元素、Cr、Mo、W、Sからなる第VI族元素、Reからなる第VII I 族元素、Fe、Co、Ir、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第VIII 族元素の少なくとも1種以上の元素が含有されている坩堝を用いて焼成が行われることを特徴とする請求項9に記載の窒化物蛍光体の製造方法。

【請求項11】

前記第2の工程、及び、前記第4の工程の少なくとも一方は、Li、Nの、K、Rb、CS、Cu、A9、Auからなる第I族元素、B、AI、Gの、Inからなる第III族元素、Ti、Zr、Hf、8n、Pbからなる第IV族元素、V、Nb、Tの、P、Sb、Biからなる第V族元素、Cr、MO、W、Sからなる第VI族元素、Reからなる第VIII族元素の少なくとも1種以上の元素が含有されている炉材を用いて焼成が行われることを特徴とする請求項9又は10のいずれかに記載の窒化物蛍光体の製造方法。

0

'n

30

【請求項12】

R(Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、 LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)と

. L(Lは、M3、Ca、Sr、Ba、Znからなる第II族元素から選ばれる少なくとも 1種以上を有する。)と、

M(Mは、C、Si、GeのうちSiを必須とする第IV族元素から選ばれる少なくとも 1種以上を有する。)と、

Li、Na、K、Rb、CS、Cu、Ag、Auからなる第 I 族元素、B、A I、Ga、Inからなる第 I I I 族元素、Ti、Z r、H f、Sn、Pb からなる第 I V 族元素、V、Nb、Ta、P、Sb、Biからなる第 V 放元素、Cr、Mo、W、Sからなる第 V I 族元素、Reからなる第 V I I 族元素、Fe、Co、I r、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第 V I I I 族元素から選ばれる少なくとも 1 種以上の元素と、

を少なくとも有する窒化物蛍光体であって、

該室化物蛍光体は、請求項8乃至11の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体の 製造方法により製造されていることを特徴とする窒化物蛍光体。

【請求項13】

500nm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルを有する発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780nmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する蛍光体と、を少なくとも有する発光装置であって、

前記蛍光体は、請求項1乃至8及び12の少なくともいずれか一項に記載の窒化物蛍光体が用いられていることを特徴とする発光装置。

【請求項14】

前記発光装置は、さらに、前記第1の発光スペクトル、及び前記第2の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、青色領域から、緑色領域、黄色領域、赤色領域までに少なくとも1以上のピーク波長がある第3の発光スペクトルを有する蛍光体を1以上有していることを特徴とする請求項13に記載の発光装置。

【請求項15】

前記第3の発光スペクトルを有する蛍光体は、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガドリニウム・アルミニウム酸化物蛍光体、及び少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガリウム・アルミニウム酸化物蛍光体の少なくともいずれか1以上であることを特徴とする請求項14に記載の発光装置。

【請求項16】

前記発光装置は、前記発光素子の光の一部と、前記第2の発光スペクトルを有する蛍光体の光の一部と、前記第3の発光スペクトルを有する蛍光体の光の一部と、のいずれか2以上の光の混色により、白色に発光することを特徴とする請求項13乃至15の少なくともいずれか一項に記載の発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体発光素子、蛍光ランプ等の照明、ディスプレイ、液晶用パックライト等に使用される発光装置、特に発光装置に使用される窒化物蛍光体に関する。

[0002]

【従来の技術】

可視光の短波長域や、近紫外領域の光の照射により発光する蛍光体は、プラックライト照明下で発光させられる、玩具、衣類などの装飾、美術品、時計の文字盤などの表示装置などに主に利用されて()る。玩具、装飾、美術品、表示装置などの用途に用いられる赤色に発光する蛍光体としては、Eu賦活の有機蛍光体や、硫化物系の無機蛍光体が主に検討さ

0

20

90

40

れ用いられている。また、可視光や紫外光を用いた発光装置にも、蛍光体は用いられている。

[0003]

半導体素子を用いた発光装置は、小型で電力効率が良く鮮やかな色の発光をする。また、発光素子ランプに用いられる発光素子は、半導体素子であるため球切れなどの心配がない。 さらに初期駆動特性が優れ、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強いという特徴を有する。このような優れた特性を有するため、半導体発光素子は、各種の光源として利用されている。

[0004]

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来の蛍光体は一般に、化学薬品、熱及び光に対して、不安定であり、高温の熱や光、若しくは水分、酸により発光特性を失うため、玩具、装飾用途や美術品のなかでも室内用途には用いられるが、屋外用途には特殊な加工が必要であり使用しにくい。更に、屋外用途で信頼性の必要な非常標識、道路標識などの表示用途には積極的に使用されている。 ない。このため、発光効率が高く、安定な赤色発光の蛍光体が要求されている。

[0006]

上述の白色発光装置は、発光に赤色成分が少なく、色温度が高く、赤みの不足した演色性の低い照明光しか得られていないという問題を有している。また、従来の赤色に発光する蛍光体は、化学的、熱的安定性が低いため、実用化されていない。

[0007]

従って、本発明は上記問題を解決し、発光効率が高く、化学的・熱的に安定な蛍光体を提供することを目的とする。また、該蛍光体を用いた発光装置を提供することを目的とする

[0008]

【課題を解決するための手段】

20

ЗU

ると、波長変換し、黄色から赤色領域等にピーク波長がある第2の発光スペクトルを有す る窒化物蛍光体である。該窒化物蛍光体に、該窒化物蛍光体の組成に含まれる元素と異な る元素を含有することにより、色調を変化させることなく、発光の強度を変化させること ができる。これにより、所望の輝度を有する窒化物蛍光体を提供することができる。また 、容易に輝度の調整を行うことができる。

[0009]

本発明は、500mm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルの少なくとも一部を 波長変換し、520~780mmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2 の発光スペクトルを有する、一般式LxMYN((2 / 3) x + (4 / 3) Y) : R 若し Ca、 S r、 B a、 Z n からなる第 I I 族元素から選ばれる少なくとも 1 種以上を有する 。 M は、 C 、 S i 、 G e の う ち S i を B 須 と す る 第 I V 族 元 素 か ら 選 ば れ る 少 な く と も 1 種以上を有する。Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dソ、 Ho、Er、LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を 有する。)で表される窒化物蛍光体であって、前記窒化物蛍光体の原料中には、前記し、 前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素が含有されていることを特徴とする窒化物 蛍光体に関する。これにより、所望の輝度を有する窒化物蛍光体を提供することができる 。また、容易に輝度の調整を行うことができる。また、本発明の窒化物蛍光体の原料、例 えば窒化ストロンチウム、窒化カルシウム、窒化ケイ素、酸化ユウロピウム若しくは窒化 ユウロピウム中に、窒化物蛍光体の組成に含まれる元素と異なる元素が、どの程度含有し ているかを調節することにより、輝度の調整を行うことができる。また、原料中に含まれ る各種の元素の含有量が目的とする発光特性の制御範囲内であれば、原料の精製工程を省 略することができるため、製造工程の簡略化を図ることができる。また、安価な製品供給 を行うことができる。

[0010]

なお、第1の発光スペクトルは、外部装置により励起されたものである。

前記室化物蛍光体の組成に含まれる元素と異なる元素は、前記室化物蛍光体の組成に含ま れる元素の重量に対して1000PPM以下であることが好ましい。この範囲であれば、 発光特性の調整を行りつつ、高輝度を保持することができるからである。明細書における 発光特性は、色調、輝度、残光、励起強度に対する光出力特性や発光効率などである。

[0012]

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、Li、Na、K、Rb、CS からなる第1族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素であることが好ましい。この Li、Na、K、Rb、CSからなる第1族元素を含有する窒化物蛍光体は、第1族元素 を含有していない窒化物蛍光体と比べて、高い発光効率を有している。これは、上記第Ⅰ 族元素が、合成中、フラックスとして働き、その後、フラックスとして働いた第1族元素 が 蛍光体粒子間に存在するため、 若しくは 第 Ⅰ 族元素 が 製造工程中に 飛 散する ため、 蛍光 体の発光やのものを阻害することが少ないからと考えられるからである。また、窒化物蛍 光体に第1族元素を含有することにより、窒化物蛍光体の粒径を制御することができる。

[0013]

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、Cu、A9、Au からなる 第 I 族元素、B、AI、Ga、Inからなる第III 族元素、Ti、Zr、Hf、Sn、P b からなる 第Ⅰ V 族元素、 P 、 S b、 B i からなる 第 V 族元素、 S からなる 第 V I 族元素 から選ばれる少なくとも 1 種以上の元素であることが好ましい。これにより、 窒化物蛍光 体の輝度の調整を行うことができる。また、AI、B、Ga、In等は、輝度の調整を行 いつつ、高輝度を保持することができる。

[0014]

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素は、V、Nb、Taからなる第V 族元素、Cr、Mo、Wがらなる第VI族元素、Reからなる第VII族元素、Fe、C

30

〇、Iと、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第VIII族元素から選ばれる少なくとも1種以上の元素である。これら第V皮元素を添加する窒化物蛍光体と、該元素を添加していない窒化物蛍光体とを比べると、第VIIを流れるの元素を生まる。これらの元素を大きないない。これらの元素を大きないできる。ここで、前記窒化物蛍光体の組成に含まれる元素を異なる第VIIIを表の重量に対して100PPM以下であることが好ましい。これは、第VBII を元素の重量に対して100PPM以下であることが好ましい。でれは、第VBII を元素の重量に対して100PPM以下であることが好ましい。でれば、第VIII を元素であり、発光を阻に下げるため、本窒化物蛍光体の発光を阻して元素であり、発光効率を大幅に下げるため、本窒化物虫をあしているため、0・1PPM2をの方面、Cア、Ni等は、残光を短くする効果を有しているため、0・1PPM2をカートPM8を含有されていても良い。

10

[0015]

本発明は、500nm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780nmの波長範囲に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する、一般式しx My N((2/3) x + (4/3) y - (2/3) x + (4/3) x + (4/3) y - (2/3) x + (4/3) x +

20

[0016]

30

[0017]

前記室化物蛍光体は、還元雰囲気中で焼成することが好ましい。還元雰囲気中で焼成することにより、含有されている添加した元素の飛散が促進され、発光輝度の向上を図ることができるからである。

40

[0018]

、S r、B a、 Z n からなる第 I I 族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)と、M の窒化物及びM の酸化物(M は、C、Si、G e のうちSiを必須とする第 I V 族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。)の少なくともいずれか1つと、を退合する第3の工程と、第3の工程より得られる混合物を還元雰囲気中で焼成する第4の工程と、を少なくとも有する窒化物蛍光体の製造方法に関する。これにより、輝度の高い窒化物蛍光体を提供することができる。また、添加する元素により、所望の発光特性を有する窒化物蛍光体を提供することができる。

[0019]

[0020]

本発明に係る室化物蛍光体は、その製造工程において窒化物蛍光体の組成と異なる元素、又は、該異なる元素を含有する化合物を添加するが、焼成の工程で該異なる元素が飛散してしまい、最終生成物である室化物蛍光体の組成中に当初添加量よりも少ない量の元素しか含まれない場合もある。従って、最終生成物である窒化物蛍光体の組成中には、該異なる元素の添加当初の配合量よりも少ない量が組成中に含まれるにすずない。また、窒化物蛍光体の粒径を制御したい場合は、該異なる元素を添加することにより制御可能である。

[0021]

[0022]

本発明は、500mm以下にピーク波長がある第1の発光スペクトルを有する発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、520~780mmの波接・一部に少なくとも1以上のピーク波長がある第2の発光スペクトルを有する蛍光体と、を少なくとも有する発光装置であって、前記蛍光体は、請求項1乃至8及び12の少なをもいずれか一項に記載の窒化物蛍光体が用いられていることを特徴とする発光装置に関する。窒化物蛍光体は、500mm以下の近紫外から可視光の短波長側領域にピーク波長がある第1の発光スペクトルを有する発光素子からの光により励起される。励起された窒化

10

20

30

40

物蛍光体は、520nm~780nmの黄から赤色領域にピーク波長がある第2の発光スペクトルを有することにより、電球色等に発光する発光装置を提供することができる。電球色とは、JIS規格(JIS Z8110)による白色系で黒体 射の軌跡上の2700~2800Kの点を中心とする範囲であって、黄色から赤色の色味を有している色味をいう。具体的には、図6の色度座量における、(うすい)黄赤、(オレンジ)ピンク、ピンク、(うすい)ピンク、(黄みの)白の領域に発光色を有するものをいう。

[0023]

また、本発明により、粒径が所定の範囲に制御された蛍光体を製造することができる。粒径が所定の範囲に制御された蛍光体を用いることにより、色むらが極めて少なり発光装置を提供することができる。されにより、輝度の高い発光装置を提供することができる。また、従来は、発光装置の色調を変えずに、発光特性を変化させることが困難であったが、本発明に係る発光装置は、添加する元素の効果により窒化物蛍光体を所望の発光特性に変更しているため、発光装置の色調を変えずに、発光特性を変化させることができる。

[0024]

前記発光装置は、さらに、前記第1の発光スペクトル、及び前記第2の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、青色領域から、緑色領域、黄色領域、赤色領域までに少なくとも1以上のピーク波長がある第3の発光スペクトルを有する蛍光体を1以上有していることが好ましい。諸種の色味に発光する蛍光体を本発明に係る窒化物蛍光体と組み合わせて使用することにより、白色だけでなく、パステルカラー等の所望の発光色を有する発光装置を提供することができる。また、白色であっても、(黄みの)白、(緑みの)白、(青みの)白等に微調整することもできる。

[0025]

前記第3の発光スペクトルを有する蛍光体は、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体、少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガリニウム・アルミニウム酸化物蛍光体、及び少なくともセリウムで賦活されたイットリウム・ガリウム・アルミニウム酸化物蛍光体の少なくともいずれか1以上であることが好ましい。これにより、所望の発光色を有する発光装置を提供することができる。例えば、本発明に係る蛍光体と、セリウムで賦活されたイットリウム・アルミニウム酸化物蛍光体等とを用いた場合、これら蛍光体の組合せにより、可視光励起にあける種々の色味の白色光を造り出すことができる。

[0026]

前記発光装置は、前記発光素子の光の一部と、前記第2の発光スペクトルを有する蛍光体の光の一部と、前記第3の発光スペクトルを有する蛍光体の光の一部と、のいずれかりと、のいずれがの混色により、白色に発光することを特徴とする。該発光装置は、種々の安光を固定は、種々の安光を置き提供することができる。該発光装置は、種々の蛍光体配合量を調整することにより、変化物蛍光体が励起され黄色光を発光することにより、変化物蛍光体及び蛍光体間をすり抜けてきたが、光と、窒化物蛍光体の黄色光とが、光の混色に関する原理によって、人間の目には、白色として見える。

[0027]

上述のL、M、N、O、Rと異なる元素は、通常、酸化物、若しくは水酸化物で加えられるが、これに限定されるものではなく、メタル、窒化物、イミド、アミド、若しくはその他の無機塩類でも良く、また、予め他の原料に含まれている状態でも良い。前記窒化物労光体の組成中に酸素が含有されている。酸素は、原料となる各種酸化物から導入されるが、焼成中に酸素が混入してくることが考えられる。この酸素は、EL拡散、粒成長、結晶性向上の効果を促進すると考えられる。すなわち、原料に使用される一の化合物をメタル、窒化物、酸化物と変えても同様の効果が得られるが、むしる酸化物を用いた場合の効果が大きい場合もある。窒化物蛍光体は、単斜晶、斜方晶系等の結晶構造を有する。

[0028]

. .

20

30

また、本発明により、蛍光体の残光特性を任意に調整することができる。PDP、CRTやLCDなどのディスプレイのように表示が連続して繰り返し行われるような表示装置では、残光特性が問題となる。半導体発光素子と蛍光体とを組み合わせた白色発光装置は、屋外ディスプレイやLCDのパックライトとして用いられる。このような用途には、短残光が要求される。そのため、蛍光体の基本構成元素に、B、M9、Cr、Ni、AIなどを含有させることにより、残光を抑えることができる。

[0029]

前記室化物蛍光体は、平均粒径が2.5~15μmであることが好ましい。特に、3~8μmであることが好ましい。粒径が大きいと発光輝度が向上し、光取り出し効率が向上するなどの利点がある。

[0030]

以上のように、本発明に係る窒化物蛍光体は、色調、輝度、残光等の発光特性の調整を容易に行える。また、発光特性を制御しつつ、安価で、簡易な製造工程を有する窒化物蛍光体を提供することができる。本発明に係る発光装置は、発光効率の良好なやや赤みを帯びた暖色系の白色発光装置を提供することができる。また、青色発光素子等と組み合わせて使用する黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体を提供することができる。従って、本発明は、窒化物蛍光体、窒化物蛍光体の製造方法、及び、それを用いた発光装置を提供することができるという技術的意義を有する。

[0031]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る蛍光体及ひやの製造方法を、実施の形態及び実施例を用いて説明する。だたし、本発明は、この実施の形態及び実施例に限定されない。

[0032]

本発明に係る発光装置は、第1の発光スペクトルを有する発光素子と、前記第1の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、第2の発光スペクトルを有する蛍光体と、を少なくとも有する発光装置である。具体的な発光装置の一例として、図1を用いて説明する。図1は、本発明に係る発光装置を示す図である。

[0033]

(発光装置1)

発光装置1は、サファイア基板1の上部に積層された半導体層2と、該半導体層2に形成された正負の電極3から延び3導電性ワイヤ14で導電接続されたリードフレーム13と、該サファイア基板1と該半導体層2とから構成され3発光素子10の外周を覆うようにリードフレーム13ののカップ内に設けられた蛍光体11とコーティング部材12と、該蛍光体11及び該リードフレーム13の外周面を覆うモールド部材15と、から構成されている。

[0034]

サファイア基板 1 上に半導体層 2 が形成され、該半導体層 2 の同一平面側に正負の電極 3 が形成されている。前記半導体層 2 には、発光層(図示しない)が設けられており、この発光層がら出力されるピーク波長は、紫外から青色領域の 5 0 0 n m 以下近傍の発光スペクトルを有する。

[0085]

この発光素子10をダイホンダーにセットし、カップが設けられたリードフレーム18のにフェイスアップしてダイホンド(接着)する。ダイボンド後、リードフレーム18をワイヤーホンダーに移送し、発光素子の負電極3をカップの設けられたリードフレーム18 a に金線でワイヤーボンドし、正電極3をもすーカのリードフレーム18 b にワイヤーボンドする。

[0036]

次に、モールド装置に移送し、モールド装置のディスペンサーでリードフレーム 1 3 のカップ内に蛍光体 1 1 及びコーティング部材 1 2 を注入する。蛍光体 1 1 とコーティング部材 1 2 とは、予め所望の割合に均一に混合しておく。

10

20

ას

40

[0037]

蛍光体11注入後、予めモールド部材15が注入されたモールド型枠の中にリードフレーム13を浸漬した後、型枠をはずして樹脂を硬化させ、図1に示すような砲弾型の発光装置1とする。

[0038]

(発光装置2)

上記の発光装置1と異なる発光装置2についての具体的構成について詳述する。図7は、 本発明に係る発光装置2を示す図である。発光装置2は、表面実装型の発光装置を形成す る。発光素子101は、紫外光励起の窒化物半導体発光素子を用いることができる。また 、発光素子101は、青色光励起の窒化物半導体発光素子も用いることもできる。ここで は、紫外光励起の発光素子101を例にとって、説明する。発光素子101としてLED チップ101は、発光層としてピーク波長が約370mmのInGaN半導体を有する窒 化物半導体発光素子を用いる。より具体的なLEDの素子構造としてサファイア基板上に 、アンドープの窒化物半導体であるり型GAN層、Siドープのり型電極が形成されり型 コンタクト層となるGAN層、アンドープの窒化物半導体であるり型GAN層、窒化物半 導体であるn型AIGaN層、次に発光層を構成するInGaN層の単一量子井戸構造と してある。発光層上にはM3がドープされたP型クラッド層としてAIGAN層、M3か ドープされたP型コンタクト層であるGAN層を順次積層させた構成としてある。(なお 、サファイア基板上には低温でGAN層を形成させパッファ層とさせてある。また、P型 半導体は、成膜後400℃以上でアニールさせてある。)。エッチングによりサファイア 基板上の窒化物半導体に同一面側で、PN各コンタクト層表面を露出させる。露出された n型コンタクト層の上にn電極を帯状に形成し、切除されずに残ったP型コンタクト層の ほぼ全面に、金属薄膜から成る透光性P電極が形成され、さらに透光性P電極の上にはn 電極と平行に台座電極がスパッタリング法を用いて形成されている。

[0089]

次に、中央部に凹部有し且つ前記凹部の両側にコパール製のリード電極102が気密絶縁的に挿入固定されたペース部とからなるコパール製パッケージ105を用いる。前記パッケージ105及びリード電極102の表面にはNi/A3層が設けられている。パッケージ105の凹部内に、A3-Sn合金にて上述のLEDチップ101をダイボンドする。このように構成することにより、発光装置の構成部材を全て無機物とすることができ、LEDチップ101から放出される発光が紫外領域或いは可視光の短波長領域であったとしても飛躍的に信頼性の高い発光装置が得られる。

[0040]

[0041]

以下、本発明に係る発光装置の構成部材について詳述する。

[0042]

(蛍光体)

本発明に係る蛍光体は、一般式 L x M y N ((2 / 3) x + (4 / 3) y) : R 若しくは L x M y O g N ((2 / 3) x + (4 / 3) y - (2 / 3) g) : R (L は、M y 、 C a.

0

20

30

٨n

、8m、Ba、Znからなる第11族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。M は、C、8i、Geのうち8iを必須とする第IV族元素から選ばれる少なくとも1種以 上を有する。Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho 、Eと、LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有す る。)で表される窒化物蛍光体であって、前記窒化物蛍光体は、前記し、前記M、前記O 、前記N、前記Rと異なる元素(以下、単に「異なる元素」という。)が含有されている ことを特徴とする窒化物蛍光体である。一般式中、X、Y及び呂は、0より大きい任意の 数値である。特に、X及びYは、X=2、Y=5又は、X=1、Y=7であることが好ま しい。 具体的には、 (8 r T C a 1 - T) 2 8 i 5 N 8 : E u 、 8 r 2 8 i 5 N 8 : E u . Ca 2 S i 5 N 8 : E u . S r T Ca 1 - T S i 7 N 1 0 : E u . S r S i 7 N 1 0 : Eu、CaSi $_1$ N $_1$ 0 : Eu等で表される窒化物蛍光体を使用することが好ましい。こ の窒化物蛍光体は、前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素が含有されて いる。該異なる元素は、Li、Na、K、Rb、CS、Cu、A9、Auからなる第1族 元素、B、AI、Ga、Inからなる第III族元素、Ti、Zァ、Hf、Sn、Pbか らなる第 I V 族元素、 P 、 S b 、 B i からなる第 V 族元素、 S からなる第 V I 族元素、 V 、Nb、Taからなる第V族元素、Cr、Mo、Wからなる第VI族元素、Reからなる 第VII族元素、Fe、Co、Ir、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第VIII族元素 から選ばれる少なくとも1種以上の元素である。これらの異なる元素が1又は2種以上が 窒化物蛍光体に含まれている。これらの異なる元素の窒化物蛍光体中の含有量は、特に限 定されないが、一般式Lx My N ((2 / 3) x + (4 / 3) y) :R若しくはLx My Og N ((2/3) x + (4/3) y - (2/3) g) : Rに対して、1000 P P m 从 下であることが好ましい。該範囲にすることにより、良好な発光特性が得られるからであ る。特に、 $0.~1\sim500$ P P M の範囲であることが好ましい。該範囲にすることにより 、更に良好な発光効率を得ることができるからである。製造工程において、異なる元素の 添加量を0.1~500PPMの範囲にするため、製造工程における焼成工程においては 、該異なる元素の全部若しくは一部が飛散する場合もあるため、原料に添加する量を10 0 0 0 P P m 以上でも目的とする性能を達成することができる場合もあるが、 1 0 0 0 P PM以下に調整することが好ましい。これにより、輝度等の発光特性の調整を図ることが できるからである。但し、本発明は、この実施の形態及び実施例に限定されない。

[0043]

しは、M分、Ca、Sr、Ba、区nのうち少なくとも1種以上からなる。例えば、SrとCaとの混合物は、所望により配合比を変えることができる。ここで、Srのみ、若しくは、Caのみのときより、SrとCaとを混合した方が、より長波長側にピーク波長がシフトする。SrとCaのモル比が、7:3若しくは3:7のとき、Ca、Srのみを用いた場合と比べて、長波長側にピーク波長がシフトしている。さかない、SrとCaのモル比が、ほぼ5:5のとき、最も長波長側にピーク波長がシフトする。

[0044]

Mは、C、Si、GeのすちSiを必須とする第IV族元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。このすち、窒化物蛍光体の組成にSiを用いることにより結晶性の良好な窒化物蛍光体を提供することができる。また、Siを95重量%用いて、Geを5重量%用いることもできる。

[0045]

Rは、Y、La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、LuのうちEuを必須とする希土類元素から選ばれる少なくとも1種以上を有する。これににいい、発光特性に優れた窒化物蛍光体を提供することができる。以下の実施例は、発光中心に希土類元素であるユウロピウムEuを用いる。ユウロピウムは、主に2価と3価のエネルギー準位を持つ。本発明の蛍光体は、母体のアルカリ土類金属系窒化ケイ素に対して、Lu 2 + を賦活剤として用いる。Eu 2 + は、酸化されやすく、3価のEu $_2$ O $_3$ の組成で市販されている。しかし、市販のEu $_2$ O $_3$ では、Oの関与が大きく、良好な蛍光体が得られにくい。そのため、Eu $_2$ O $_3$ からOを、系外へ除去したものを使用することが好

10

20

30

40

ましい。たとえば、ユウロピウム単体、窒化ユウロピウムを用いることが好ましい。さらに、Euと他の賦活剤、例えばCe、Nd等を共賦活させることにより、色調を変化することができ、発光効率の調整を行うことができる。

[0046]

前記し、前記M、前記O、前記N、前記Rと異なる元素を添加した場合の効果は、上述したように、Eu²+の拡散を促進し、色調、発光輝度、残光等の発光特性の向上を図ることができる。さらに、Cとができる。また、粒径を大きく制御して、輝度の向上を図ることができる。さらに、Cと、Ni等は、残光を短くしたりする。上述の異なる元素は、原料中に含有させるが、又は、製造工程中に単体若しくは化合物の状態で含有させ、原料と共に焼成する。但し、上述の異なる元素は、焼成後の窒化物蛍光体中に含有されていない場合もある。これは、焼成工程において、上述の異なる元素が飛散したためであると思われる。

[0047]

本発明に係る蛍光体11は、発光素子10によって発光された紫外から青色領域の光の一部を吸収して黄から赤色領域の光を発光する。この蛍光体11を上記の構成を有する発光 装置に使用して、発光素子10により発光された青色光と、蛍光体の赤色光とが混色により暖色系の白色発光装置を提供する。

[0048]

特に蛍光体11には、上述の窒化物蛍光体の他に、前記第1の発光スペクトル、及び前記第2の発光スペクトルの少なくとも一部を波長変換し、青色領域から、緑色領域、黄色領域、赤色領域までに少なくとも1以上のピーク波長がある第3の発光スペクトルを有する蛍光体を1以上有することができる。これにより、発光色を多色化することができる。

[0049]

[0050]

 10

20

30

40

[0051]

[0052]

(蛍光体の製造方法)

次に、図 2 を用いて、本発明に係る蛍光体、B を含有するC α_2 α_2 α_3 α_4 α_5 α_5 α_6 α_6

[0053]

原料のCaを粉砕する(P1)。原料のCaは、単体を使用することが好ましいが、イミド化合物、アミド化合物を使用することもできる。また原料Ccuは、しいのである。原料は、精製したものがましい。でいたより、精製工程を含有するものでもよい。原料は、精製したものがましい。では、特製工程を必要としないため、蛍光体の製造工程を簡略化でき、安価な空間光体を提供することができるからである。原料のCaは、アルコン雰囲気中、グロープボックス内で粉砕を行う。Caの粉砕の目安としては、平均粒径が約0.1μmμーであることが、他の原料との反応性、焼成時及び焼成後の粒径制御との観点から好ましいが、この範囲に限定されない。Caの純度は、2N以上であることが好ましいが、これに限定されない。

[0054]

原料のCaを、窒素雰囲気中で窒化する(P2)。この反応式を、化1に示す。

[0055]

【化1】

 $3Ca + N_2 \uparrow Ca_3 N_2$

[0056]

Caの窒化物を粉砕する(P3)。Caの窒化物を、アルゴン雰囲気中、若しくは、窒素 50

20

10

90

雰囲気中、グロープポックス内で粉砕を行う。

[0057]

原料のSiを粉砕する(P4)。原料のSiは、単体を使用することが好ましいが、窒化物化合物、イミド化合物、アミド化合物などを使用することもできる。例えば、SigN4、Si(NH2)2、M92 Siなどである。原料のSiの純度は、3N以上のものが好ましいが、Li、Na、K、B、AI、Cuなどの異なる元素が含有されていてもよい。Siも、原料のCaと同様に、アルゴン琴囲気中、若しくは、窒素雰囲気中、グロープボックス内で粉砕を行う。Si化合物の平均粒径は、約0.1μm以上15μm以下の範囲であることが他の原料との反応性、焼成時及び焼成後の粒径制御などの観点から好ましい。

10

[0058]

原料のSiを、窒素雰囲気中で窒化する(P5)。この反応式を、化2に示す。

[0059]

【化2】

ケイ素 S i も、窒素雰囲気中、 8 0 0 ~ 1 2 0 0 ℃、約 5 時間、窒化して、窒化ケイ素を得る。本発明で使用する窒化ケイ素は、高純度のものが好ましい。

[0060]

同様に、Siの窒化物を粉砕する(P6)。

[0061]

20

次に、Euの化合物Eu2〇3に、Bの化合物H3BO3を湿式混合する(P7)。Euの化合物として、酸化ユウロピウムを使用するが、金属ユウロピウム、窒化ユウロピウムなども使用可能である。このほか、原料のEuは、イミド化合物、アミド化合物を用いることもできる。酸化ユウロピウムは、高純度のものが好ましい。Bの化合物等の異なる元素を湿式混合するが、乾式混合することもできる。これらの混合物は、酸化されやすいものもあるため、AY雰囲気中、又は、窒素雰囲気中、プローブボックス内で、混合を行う

[0062]

本発明では、坩堝、炉材構成元素、若しくは原料中へ特定元素が混入した場合の影響を特定するため、各元素を窒化物へ拡散しやすい状態で加える。ここで加えられる各元素の塩類は、坩堝、炉材の通常の形態、単体金属、若しくは酸化物と同等、若しくはやれ以上の元素の拡散性を有すると推定している。

30

[0063]

Bの化合物H3 BO3 を例にとって、窒化物蛍光体の製造方法を説明するが、B以外の具なる元素には、Li、Na、K等があり、これらの化合物、例えば、H2 MOO4、LCOH・H2 O、Na2 CO3、K2 CO3、RbCI、CSCI、M分(NO3)2、CCCI2・6H2 O、BaCI2・2H2 O、TiOSO4・H2 O、ZrO(NO3)2、HfCI4、VCI3、Nb2 O5、TaCI5、Cl1、H2 O、CCI2・6H2 O、BaCI2・2H2 O、TaCI5、Cl1、Cl2・H2 O、TaCI5、Cl1、Cl2・H2 O、CCI3、RuCl3・2H2 O、CO(NO3)3・6H2 O、NiCl2・H2 O、IrCl3、PdCl3、PdCl3、LCCI3、PdCl3、COO)2・H2 O、A9 NO3、HALUCl4・4H2 O、Zn(NO3)2・6H2 O、H3 BO3、AI(NO3)3・9H2 O、GaCI3、InCl3、GeO2、Sn(CH3 COO)2、Pb(NO3)2・6H2 O、H3 BO3、AI(NO3)3・9H2 O、GaCl3、InCl3、GeO2、Sn(CH3 COO)2、Pb(NO3)2(9を使用することができる。これら化合物をCaの窒化物、Siの窒化物、Euの化合物等の原料組成中に、

40

[0064]

異なる元素が含有されていてもよい。

Euの化合物Eu₂O₃と、Bの化合物H₃BO₃との混合物を、酸化雰囲気中で焼成する(P8)。

[0065]

EuとBの混合物を粉砕する(P9)。粉砕後のEuとBの混合物の平均粒径は、約0. 1 4 m から 1 5 4 m であることが好ましい。

[0066]

上記粉砕を行った後、Caの窒化物、Siの窒化物、EuとBの混合物を混合する(P1 0).

[0067]

Caの窒化物、Biの窒化物、EuとBの混合物をアンモニア雰囲気中で、焼成する(P 11)。焼成により、Bが添加されたCa2Si5N8:Euで表される蛍光体を得るこ とができる(P12)。この焼成による窒化物蛍光体の反応式を、化るに示す。

10

[0068]

[化3]

$$\frac{1.985}{3} \text{ Ca}_{3}\text{N}_{2} + \frac{5}{3}\text{Si}_{3}\text{N}_{4} + \frac{0.015}{2} \text{Eu}_{2}\text{O}$$

Ca_{1, 985} Eu_{0, 015} Si₅ N_{7, 990} O_{0, 0225}

20

[0069]

ただし、各原料の配合比率を変更することにより、目的とする蛍光体の組成を変更するこ

[0070]

焼成は、管状炉、小型炉、高周波炉、メタル炉などを使用することができる。焼成温度は 、1200から2000℃の範囲で焼成を行うことができるが、1400から1800℃ の焼成温度が好ましい。焼成は、徐々に昇温を行い1200から1500℃で数時間焼成 を行う一段階焼成を使用することが好ましいが、800から1000℃で一段階目の焼成 を行い、徐々に加熱して1200から1500℃で二段階目の焼成を行う二段階焼成(多 段階焼成)を使用することもできる。蛍光体11の原料は、窒化ホウ素(BN)材質の坩 堝、ホートを用いて焼成を行うことが好ましい。窒化ホウ素材質の坩堝の他に、アルミナ (AI2O3) 材質の坩堝を使用することもできる。これらB、AI等は、MOよりも、 輝度の向上を図ることができ、高い発光効率を有する蛍光体を提供することができるから である。

[0071]

また、還元雰囲気は、窒素、水素、アルゴン、二酸化炭素、一酸化炭素、アンモニアの少 なくとも1種以上を含む雰囲気とする。ただし、これら以外の還元雰囲気下でも焼成を行 うことができる.

[0072]

以上の製造方法を使用することにより、目的とする蛍光体を得ることが可能である。

40

本発明において発光素子は、蛍光体を効率よく励起可能な発光波長を発光できる発光層を 有する半導体発光素子が好ましい。このような半導体発光素子の材料として、BN、Si C. Zn 8 e & Gan. In Gan. In Al Gan. Al Gan. BAl Gan. BI NAIGANなど種々の半導体を挙げることができる。同様に、これらの元素に不純物元 索としてSiや呂Nなどを含有させ発光中心とすることもできる。蛍光体を効率良く励起 できる紫外領域から可視光の短波長を効率よく発光可能な発光層の材料として特に、窒化 物半導体(例えば、AIやGAを含む窒化物半導体、InやGAを含む窒化物半導体とし 7 I n x A l y G a 1 - x - y N 、 0 < X < 1 、 0 < Y < 1 、 X + Y ≤ 1) がより好適に 挙けられる。

40

50

[0073]

また、半導体の構造としては、MIS接合、PIN接合やPN接合などを有するホモ構造、ヘテロ構造あるいはダブルヘテロ構成のものが好適に挙げられる。半導体層の材料やその混晶比によって発光波長を種々選択することができる。また、半導体活性層を量子効果が生ずる薄膜に形成させた単一量子井戸構造や多重量子井戸構造とすることでより出力を向上させることもできる。

[0074]

室化物半導体を使用した場合、半導体用基板にはサファイア、スピネル、SiC、Si、 NO、GaAS、GaN等の材料が好適に用いられる。結晶性の良い室化物半導体を量産性よく形成させるためにはサファイア基板を利用することが好ましい。このサファイア 基板上にHVPE法やMOCVD法などを用いて窒化物半導体を形成させることができる。サファイア基板上にGaN、AIN、GaAIN等の低温で成長させ非単結晶となるパッファ層を形成しその上にPN接合を有する窒化物半導体を形成させる。

[0075]

[0076]

室化物半導体は、不純物をドープしない状態で n 型導電性を示す。発光効率を向上させるなど所望の n 型室化物半導体を形成させる場合は、 n 型ドーパントとして S i、 G e e、 T e、 C 等を適宜導入することが好ましい。一方、 P 型窒化物半導体を形成させる場合は、 P 型ドーパントである Z n、 M 分、 B e、 C a、 S r、 B a 等をドープさせることが好ましい。室化物半導体は、 P 型ドーパントをドープしただけでは P 型化しにくいたが P 型ドーパント 導入後に、 P 型ドーパントをドープしただけでは P 型化してくいため P 型ドーパント 導入後に、 が C よる 加熱やプラズ マ 照射等により 低抵抗化させることが B 1 の コンタクト 層上に されて 2 とらい 5 サファイア 基板を 2 とらない場合は、 第 1 の コンタクト 層上に されて 2 を ができる。 各 コンタクト 層上に されて 8 光素子を 形成させることができる。

[0077]

発光装置において、量産性よく形成させるためには透光性封止部材を利用して形成させることが好ましい。特に、蛍光体11を混合して封止することため、透光性の樹脂が好ましい。この場合蛍光体からの発光波長と透光性樹脂の劣化等を考慮して、発光素子は紫外域に発光スペクトルを有し、その主発光波長は360mm以上420mm以下のものや、450mm以上470mm以下のものも使用することができる。

[0078]

ここで、半導体発光素子は、不純物濃度10^{~~}~10²⁰ /cm³ で形成される n 型コンタクト層のシート抵抗と、透光性 P 電極のシート抵抗とが、 R P ≥ R n の関係となるように調節されていることが好ましい。 n 型コンタクト層は、例えば膜厚3~10μm、より好ましくは4~6μmに形成されると好ましく、 そのシート抵抗は10~15Ω/□と見積もられることがら、 このときのR P は前記シート抵抗値以上のシート抵抗値を有するように薄膜に形成するとよい。また、透光性 P 電極は、 膜厚が150μm以下の薄膜で形成されていてもよい。また、 P 電極は金属以外のITO、 Z n O も使用することができる

。ここで透光性P電極の代わりに、メッシュ状電極などの複数の光取り出しよ用開口部を備えた電極も使用することができる。

[0079]

また、透光性P電極が、金および白金族元素の群から選択された1種と、少なくとも1種の他の元素とから成る多層膜または合金で形成される場合には、含有されている金または白金族元素の含有量により透光性P電極のシート抵抗の調整をすると安定性および再現はが向上される。金または金属元素は、本発明に使用する半導体発光素子の波長領域における吸収係数が高いので、透光性P電極に含まれる金叉は白金族元素の量は少ないほど透明ではRP≧Rハであるので、透光性P電極は従来のものと比較して薄膜に形成されることでなるが、このとき金または白金族元素の含有量を減らすことで薄膜化が容易に行える

10

20

[0080]

上述のように、本発明で用いられる半導体発光素子は、 n 型コンタクト層のシート抵抗 R n Ω / □と、 透光性 P 電極のシート抵抗 R P Ω / □とが、 R P ≧ R n の関係を成していることが好ましい。 半導体発光素子として形成した後に R n を測定するのは難しく、 R P と R n との関係を知るのは実質上不可能であるが、発光時の光強度分布の状態からどのような R P と R n との関係になっているのかを知ることができる。

[0081]

透光性 P 電極 と n 型コンタクト層とが R P ≥ R n の関係であるとき、前記透光性 P 電極上に接して延長伝導部を有する P 側台座電極を設けると、さらなる外部量子効率の向上を図ることができる。延長伝導部の形状及び方向に制限はなく、延長伝導部が衛線上である場合、光を遮る面積が減るので好ましいが、メッシュ状でもよい。また形状は、直線状以外に、曲線状、格子状、枝状、 状でもよい。このとき P 側台座電極の総面積に比例して遮光効果が増大するため、遮光効果が発光増強効果を上回らないように延長導電部の線幅及び長さを設計するのがよい。

[0082]

(発光素子)

上述の紫外光励起の発光素子と異なる青色光励起の発光素子を使用することもできる。青色光励起の発光素子10は、III属室化物系化合物発光素子であることが好ましい。発光素子10は、例えばサファイア基板1上にGのNパッファ層を介して、Siがアンドープのn型GのN層、Siがドープされたn型GのNからなるn型コンタクト層、アンドープGのN層、多重量子井戸構造の発光層(GのN障壁層/InGのN井戸層の量子井戸構造)、M分がドープされたP型GのNからなるP型GのNからなるPクラッド層、M分ドープされたP型GのNからなるP型コンタクト層が順次積層された積層構造を有し、以下のように電極が形成されている。但し、この構成と異なる発光素子10も使用できる。

【0083】 Pオーミック電極は、P型コンタクト層上のほぼ全面に形成され、そのPオーミック電極 上の一部にPパッド電極3が形成される。

[0084]

40

また、n電極は、エッチングによりP型コンタクト層からアンドープGaN層を除去してn型コンタクト層の一部を露出させ、その露出された部分に形成される。

[0085]

なお、本実施の形態では、多重量子井戸構造の発光層を用いたが、本発明は、これに限定されるものではなく、例えば、InGaNを利用した単一量子井戸構造としても良いし、 8i、Zn等のn型、P型不純物がドープされたGaNを利用しても良い。

[0086]

また、発光素子10の発光層は、Inの含有量を変化させることにより、420nmから490nmの範囲において主発光ビークを変更することができる。また、発光波長は、上記範囲に限定されるものではなく、860~550nmに発光波長を有しているものを使

用することができる。

[0087]

(コーティング部材)

コーティング部材12(光透光性材料)は、リードフレーム13のカップ内に設けられるものであり発光素子10の発光を変換する蛍光体11と混合して用いられる。コーティング部材12の具体的材料としては、エポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性、耐候性に優れた透明樹脂、シリカゲル、ガラス、無機パインダーなどが用いられる。また、蛍光体11と共に拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン、酸化アルミニウムなどを含有させても良い。また、光安定化剤や着色剤を含有させても良い。

[0088]

(リードフレーム)

リードフレーム13は、マウントリード13瓜とインナーリード136とから構成される

[0089]

マウントリード13のは、発光素子10を配置させるものである。マウントリード13のの上部は、カップ形状になってあり、カップ内に発光素子10をダイボンドし、該発光である。カップ内に発光素子10を複数配置と対して利用することを変まる。この場合、十分な電気伝導性と呼吸がイボンドで積減のは、熱硬化性樹脂などである。カップウントリード13のの場合、十分な電気伝導性と導電性ワイヤ14年の場合、十分な電気伝導性と導電性ワイボンドには、熱硬化性樹脂などによって行うことができる。熱硬化性樹脂などが持着は、アクリル樹脂、イミド樹脂などが挙げられる。また、フェースを光素子10とアウントリード13のカップとの対策者によりアウントリード13のとダイボンドすると共に電気的接続を行うには、A9ースと、カーボンペースト、金属パンプなどを用いることができる。また、無機パインダーを用いることをできる。

[0090]

インナーリード136は、マウントリード13の上に配置された発光素子10の電極3から延びる導電性ワイヤ14との電気的接続を図るものである。インナーリード136は、マウントリード130次の電気的接触によるショートを避けるため、マウントリード13のから離れた位置に配置することが好ましい。マウントリード13の上に複数の発光素子10を設けた場合は、各導電性ワイヤ同士が接触しないように配置できる構成にする必要がある。インナーリード136は、マウントリード13のと同様の材質を用いることが好ましく、鉄、鋼、鉄入り鋼、金、白金、銀などを用いることができる。

[0091]

(導電性ワイヤ)

導電性ワイヤ14は、発光素子10の電極3とリードフレーム13とを電気的に接続するものである。導電性ワイヤ14は、電極3とオーミック性、機械的接続性、電気導電性及び熱伝導性が良いものが好ましい。導電性ワイヤ14の具体的材料としては、金、銅、白金、アルミニウムなどの金属及びされらの合金などが好ましい。

[0092]

(モールド部材)

 10

20

ያስ

40

しては、チタン酸パリウム、酸化チタン、酸化アルミニウム等が好ましい。コーティング部材12との材質の反発性を少なくするため、屈折率を考慮するため、同材質を用いることが好ましい。

[0093]

以下、本発明に係る蛍光体、発光装置について実施例を挙げて説明するが、この実施例に 限定されるものではない。

[0094]

なお、温度特性は、25℃の発光輝度を100%とする相対輝度で示す。粒径は、F.8.8.NO. (Fisher Sub Sieve Sizer S NO.) という空気透過法による値である。また、残光は、室温(20℃)で253.7nmの光を一定時間照射した後、励起光源のランプを非点灯とする。時間の基準は、この励起光源のランプを非点灯とした瞬間の時間を0と定める。励起光源照射中の輝度を100%の輝度基準とした場合、輝度が1/10まで減衰するまでに要する時間を測定する。この測定の結果を基準に、残光特性を決定する。

[0095]

【実施例】

表1は、本発明に係る窒化物蛍光体の実施例1乃至80の特性を示す。

[0096]

また、図 3 は、実施例 6 0 の窒化物蛍光体をE×=460mmで励起したときの発光スペクトルを示す図である。図 4 は、実施例 6 0 の窒化物蛍光体の励起スペクトルを示す図である。図 5 は、実施例 6 0 の窒化物蛍光体の反射スペクトルを示す図である。

[0097]

【表 1 】

n

П		添加量			元素	色調	色飘	輝度	量子効	粒径	残光	泪席	特性
	元案	(ppm)	添加源分子量	は楽メーカー	分子量	X	y y	Y (%)	率 Q(%)	(\tau =)	(msec)	100°C	200℃
$\overline{}$	Li	100	LiOH·H ₂ O	wako 試薬特級	6.94	0.685	0.407	205.5	211.8	2.5	28		
2	Li	500	41.95	124-01212		0. 685	0.407	196. 2	201.8	2.3	30	95, 4	65.5
3	Na	100	Na,CO,	wako 試薬特級	22.99	0.584	0.407	210.9	215.9	2.6	14		
4	Ŋа	500	105. 99	197-01585		0.585	0.406	215.5	221.4	2.7	22	97.1	70.3
Ĝ	K	100	K2CO3	vako 試案特級	39. I	0.585	0.406	209.8	216.4	2. 5	24		
6	K	500	138. 21	162-03495		0.585	0.407	210. 2	216.4	2.6	26	1.60	66.1
7	Rb	100	RbCI	wako 試薬特級	8542	0. 585	0.407	217.1	221.6	2.4	22		
8	Rb	500	120. 92	187-00321		0.585	0.407	205.1	209.8	2.5	30	96.6	69.5
9	Cs	100	CsCl	wako 試薬特級	132.91	0. 584	0,407	192.6	183.1	2. 2	18	24-2	20.4
10	Cs	500	168.36	035-01952	24.81	0. 585	0.407	202.0	192.0	2.5	18	94.3	66.4
11	Ng	100	Mg (NO 3) 2	wako 試案特級	24. 31	0.586	0.407	215.5	220.5	2.7	32	85.5	66.5
12	Ng	500	5.5%	134-00255 wako 試薬特級	87.62	0.586	0.407	216.0	202.3	2. 4	22	80.0	00.0
13	Sr_	100	SrCl: 6H2O	197-04185	87.02	0. 584	0.407	206. 7	195.9	2.5	26	97.3	70.8
14	Sr_Ba	500 100	266.64 BaCl, · 2H ₂ O	wako 武率特級	137.33	0. 587	0.405	224.8	231.9	2.7	18	91.0	10.0
16	Ba	500	244. 26	029-00175	131.33	0. 586	0.407	215.5	220. B	2.6	20	97.5	72. 1
17	Ti	100	7i0S04 · H20	キシダ化学	47.9	0.585	0.409	218. 2	222.1	2.8	14		
18	Ti	500	177.98	020-78905	31,3	0. 584	0.409	208.4	212.3	3, 2	14	98. 1	65.7
19	21	100	Zr0(NO ₃)	三津和化学	91. 22	0.586	0.407	214.9	221.0	2.6	20	30. 1	- · · · · ·
20	21	500	267.3		31. 28	0.586	0.408	206.7	211.8	2.7	34	98.4	74.4
21	Hí	100	HfC1.	三菜化学	178, 49	D. 584	0.407	193.6	198. 2	2.5	30		
22	Bf	500	320. 3	No 51872	110.10	D. 583	0.408	192.0	194.5	2.5	30	93.4	61.2
23	ν.	100	YC1 ₃	wako 試婆特級	50.94	0.585	0.407	214.9	220.5	3.1	26		
24	Ÿ	500	157. 30	221-00452		0.582	0.411	164.7	166.5	3.1	26	97.9	69.9
25	Nb	100	Nb,0,	wako 試薬特級	92.91	0.584	0.408	190.7	193.8	2.3	26		
26	Nb	500	265.8	144-05332		0.583	0.409	191.1	192.7	2.5	26	99.1	74.8
27	Ta	100	TaCls	キシダ化学	180, 95	0.585	0.108	218.2	222.8	2.6	18		
Z8	Ta	500	358. 21	U20-76055		0.583	0.411	190.9	192.0	2.7	18	96.5	64.6
29	Cr	100	Cr (NO ₃), · 9H ₂ O	wako 試來特級	52	0.582	0.411	167.6	169.7	2.6	10		
30	Cr	500	400.14	033-03175		0.579	0.412	100.0	100.0	2, 6	12	93.6	58.6
31	Жо	100	H ₂ MoO ₄	NAKARAIケミカ	95, 94	0.583	0.402	197.3	200.2	2.5	20		L
32	Мо	500	179.98	ル		0.581	0.410	174.3	175.4	2.6	32	97.9	72.7
33	77	100	H,WD.	wako 試蒸特級	183, 85	0.584	0.409	208. 6	213.4	2,9	22	 _	
34	*	500	249.88	209-03452		0.584	0.409	187.8	190.4	2.9	22	98.2	71.2
35	Re	100	ReCl 6	三菜化学	186. 2	0.584	0.407	207. 8	211.8	2.4	22	20.2	05.6
36	Re	500	363. 47	No 58374		0.583	0.409	193.6	196.1	2.5	32	93.7	65. 8
37	Fe	100	FeCl 3 · 3H20	wako 試薬特級	55. 85	0.581	0.410	149.9	152. 2	2.4	42	99.6	79.6
38	Fc	500	270.3	9-87	50.02	0.580	0.411	113.5	114.8	2.4	16	33.0	13.0
39	Co	100	Ca (NO 1) 2 · 6H 50	wako 試業特級 035-03755	58.93	0.585		151.0	152. 2	2.7	18	96.5	57.7
40	Co	500	291.03		192.22	0.581	0.411	195.7	200.3	2. 7	22	50.0	V'. 1
41	lr V-	100	IrCl ₃	wako 試薬特級 096-01601	192.22	0. 583	0.410	183.7	186.5	2.4	22	97.5	70. 1
42	11	100	298. 57	vako 試薬特級	58.71	0. 582	0.410	163.0	165.6	2.7	12	1-3	- · · · · ·
43	Ni Ni	500	NiC1, · 6H,0 237.72	141-01062	20.11	0. 580	0.411	112.0	113.4	2.8	20	98. 3	72.5
44	Pd	100	PdCl 2	wako 試薬特級	106.42	0. 583	0.411	191.0	193.6	2.5	20	10.5	
45	Pd	500	177. 31	162-00053	100.12	0. 582	0.410	156.5	168.4	2.4	22	98.6	73.0
47	Pt	100	HaPtCl 6 · 6HaO	wako 試塞特級	195.08	0. 582	0.411	194.7	197.0	2.5	24	T	
48	Pt	500	517.90	169-02861	1 30	0.581	0.410	181.6	183.8	2.4	24	98.1	72.0
49	Ru	100	RuCl , · 2H,0	キシダ化学	101.07	0.584	0.407	205. 5	209.8	2. 5	20		
50	Ru	500	244. 2	020-68601		0.582	0.409	173.8	175.4	2.5	28	97.9	69.8
51	Cu	100	Cu (CH 3COO) 2 · H2O	wako 試案特級	63.54	0.586	0.406	214.9	193.6	2.5	24		
52	Cu	500	199.65	3-402		0.586	0.406	208. 2	168.3	2. 6	32	97.8	70. 6
63	Ag	100	Ag(NO ₃)	wake 試業特級	107.8	0. 585	0.406	205.1	220. 7	2. 2	24		
54	Ag	500	169.8	198-00835		0.585	0.407	204.7	214.1	2.3	26	96.7	68.1

10

20

55	Au	100	HAUCI 4 - 4H ₂ O	Wako 試媒特級	196.97	0.584	0.407	205. l	210.9	2. 2	22		
56	Au	500	411.9	077-00931		0.583	0.409	204.7	209.8	2.4	24	98.2	71.2
57	Zn	100	Zn (NO 3) 3 · 6H2O	wako 試築特級	65.37	0. 585	0.407	208.6	213.7	2.6	20		
58	Zn	500	297. 49	265-01032		0.584	0.408	195.8	200.0	2.3	22	93.2	63.0
59	В	100	н,во,	wako 試染特級	10.81	0.588	0.405	234.6	244.6	3.1	20		
60	В	500	61.84	021-02195		0.588	0.405	237.9	248. 1	3.3	22	96.9	69.9
51	Αl	100	AI (NO ₁), · 9H ₂ O	wako 試業特級	26. 98	0.585	0.407	181.2	186. 3	2.5	22		
62	Αl	500	375. 14	018-01945		0.586	0.407	191.1	196.1	2.7	26	95.7	68.1
63	Ga	100	GaCl ₃	日亚化学工業株	69.72	0.585	0.407	213.3	218.5	2. 5	24		
64	Ga	500	176.09	式会社製		0.585	0.407	213.3	218.0	2. 7	38	97.1	68.2
65	In	100	InCl,	日亜化学工業株	114.82	0.585	0.407	210. 2	215.3	2.5	26		
66	In	500	221.2	式会社製		0.585	0.407	204. 7	208.9	2.4	22	96.9	64.6
67	Ge	100	GeO;	wako 試棄特級	72.59	0.585	0.407	199.8	204. 6	2.4	24		
68	Ge	500	104.6	071-04552		0.584	0.408	186.9	190.7	2.5	24	96. 1	63.8
69	Sn	100	Sn (CH , COO) ,	キシダ化学	118.69	0. 585	0.407	201.3	205.7	2. 2	22		
70	Sn	500	236.78 (90%)	lot F07553D+E8		0. 584	0.408	185.4	188.4	2. 2	24	97.8	66. 1
71	Pυ	100	Pb(NO ₃);	wako 試薬特級	207. 20	0. 585	0. 407	203. 1	192.9	2.5	20		
72	Pb	5 0 0	331.21	124-00612		0. 585	0.407	208. 2	198. 2	2.4	26	97.0	70, 4
73	P	100	(MIL) JIPO.	wako 武薬特級	30.97	0.584	0.407	204. 7	209.3	2. 2	28		
74	P	500	132.08	016-03325		0.584	0.408	202. 4	205.7	2. 3	22	95.4	60.8
75	Sb	100	Sp302	Waku 試築特級	121.75	D. 585	0.407	207. 1	211.4	2.5	22		
76	Sb	500	291.5	016-11652		0.584	0.408	186.3	189. 5	2. l	24	96.7	61.0
77	Bi	100	Bi (NO ₃) ₃ · 5H ₂ O	wako 試蒸符級	208.98	0.584	0.407	205. 5	210. 3	2. 2	24		
78	Bi	500	485.07	024-09042		0.583	0.408	173.4	175.8	2. l	26	96.7	65.1
79	S	100	(NH ₄) 2SO ₄	wako 試案特数	32.06	0.585	0.407	197.8	203. 4	2.5	26		
80	S	500	132	019-03435		0.586	0.407	200.4	209. 3	2.5	34	97.3	69.8

10

[0098]

30

20

[0099]

まず、原料のC α を $1 \sim 1$ 5 μ m に粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、C α の窒化物を 0 . $1 \sim 1$ 0 μ m に粉砕した。原料のC α を 2 0 9 秤量し、2 化を行った。

[0100]

同様に、原料のSiを1~15μmに粉砕し、窒素雰囲気中で窒化した。その後、Siの窒化物を0.1~10μmに粉砕した。原料のSiを20分秤量し、窒化を行った。

[0101]

次に、Euの化合物Eu2O3に、異なる元素を含有する化合物を湿式混合した。異なる元素を含有する化合物として、 H_3BO_3 を例にとって説明する。Euの化合物Eu2O3を20分、 H_3BO_3 を3.65分秤量した。 H_3BO_3 を溶液とした後、Eu2O3に混合し、乾燥した。乾燥後、700℃~800℃で約5時間、酸化雰囲気中で焼成を行った。これによりBが添加された酸化ユウロビウムが製造された。この焼成後、EuとBとの混合物を0.1~10μmに粉砕した。

[0102]

C α の 室 化 物、 β は の 室 化 物、 E u と B の 退合 物 を、 室 素 雰 囲 気 中 で 退合 し た。 実 施 例 1 乃 至 8 0 に お い て、 原 料 の 各 元 素 の 退合 比 率 (モ ル 比) は、 C α : β は : E u = 1 . 9 8 5 : 5 : 0 . 0 1 5 で あ 3 。 こ の 退合 比 率 に な 3 よ う に 、 C α 3 3 % (分 子 量 1 4 8 . 2 6) を 5 . 7 3 3 % 、 β 、 β は β 8 と β 9 9 % E u と B の 退合 物

をO. 373(うち、Euは、O. 31)になるように秤量し、退合を行った。これより 、添加したBの量は500PPmとなる。同様に、実施例1乃至80も同様に、異なる元 素が100PPm、500PPmとなるように、Euと異なる元素との退合、焼成、粉砕 後、秤量を行った。実施例1乃至80の窒化物蛍光体に添加する異なる元素は、LiOH ·H₂O(wako試業特級124-01212)、Na₂CO₃(wako試業特級1 97-01585)、K2CO3 (Wako試業特級162-03495)、RbCl (wako試業特級187-00321)、CSCI(wako試業特級035-0195 2)、M9(NO3)2(wako試薬特級134-00255)、CaCl2:6H2 O(wako試薬)、SrCl2・6H2O(wako試薬特級197-04185)、 Bacl₂·2H₂O(wako試薬特級029-00175)、TiOSO₄·H₂O (キシダ化学020-78905)、区とO(NO3)2(三津和化学)、HfCl4(三葉化学NO. 5 1 8 7 2)、VC I a (Wako試藥特級 2 2 1 - 0 0 4 5 2)、N b 20g (Wakの試薬特級144-05332)、Taclg (キシダ化学020-76 055)、Cr(NO₃)₃・9H₂O(wako試薬特級033-03175)、H₂ WOa (Wako試棄特級209-03452)、ReCl5 (三葉化学No. 5837 4)、FeCla·3H2O(wako試業特級9-87)、RuCla·2H2O(キ シダ化学020-68601)、CO(NOa)a.6H,O(WOKO試業特級035 -03755)、NiClo·HoO(wako試業141-01062)、IrClo (wako試薬特級096-01601)、PdCl2(wako試薬特級162-00 053)、H₂PtCl₈·6H₂O(wako試薬特級169-02861)、Cu(CHaCOO) · H · O (Wako試業特級3-402)、APNO3 (Wako試業 特級 1 9 8 - 0 0 8 8 5) 、 H A u C l 4 · 4 H 2 O (w a k o 試 薬 特級 0 7 7 - 0 0 9 31)、Zn(NO3)2·6H2O(wako試業特級265-01032)、H3B O 3 (Wako試業特級021-02195)、A | (NO 3) 3·9 H 2 O (Wako 試薬特級 0 1 8 - 0 1 9 4 5) 、GaCl3 (日亞化学工業株式会社製)、InCl3 (日亞化学工業株式会社製)、GeO₂(wako試業特級071-04552)、Sn(CH3 COO) 2 (キシダ化学 I O t F O 7 5 6 3 D)、 P b (NO3) 2 (Wako試 葉特級124-00612)、(NH4)2 HPO4 (Wのkの試薬特級016-033 25)、8 b 2 O 3 (Wako試業特級016-11652)、B i (NO 3) 3·5 H 。O(WakO試業特級024-09042)、(NH4)2804(WakO試業特級 0 1 9 - 0 3 4 3 5) である。これら化合物中における異なる元素の濃度が、添加するこ **α 2 S i 5 N 8 : E u に対して 1 O O P P m 又は 5 O O P P m になるよう秤量し添加した**

[0103]

上記異なる元素を有する化合物を混合し、焼成を行った。焼成条件は、アンモニア雰囲気中、窒化ホウ素坩堝に投入し、室温から約5時間かけて徐々に昇温して、約1850℃で5時間、焼成を行い、ゆっくりと5時間かけて室温まで冷却した。焼成により異なる元素が発散してしまい、最終生成物中に異なる元素が含有されていない場合もある。異なる元素が含有している場合でも、当初添加量よりも少ないの、1PPm~数百PPm程度が残存している。

[0104]

実施例1乃至80の窒化物蛍光体の輝度及び量子効率は、Cァを500PPm添加したときを100%とし、これを基準に相対値で表す。

[0105]

実施例1万至10のLi、N α 、K、Rb、CSからなる第1族元素は、高輝度及び高量子効率を有する。これは、フラックス効果によるものと考えられる。第1族元素の添加量を調整することにより、輝度を調節することができる。

[0106]

実施例11乃至16、57及び58は、前記しに相当する第II 族元素であり、M3、Sァ、Ba、Znが100PPm、500PPm含有されている。 窒化物 蛍光体のしの量を

IU

20

30

調整することにより、輝度の調整を行うことができる。

[0107]

実施例17乃至22のTi、 区 ア、 Hfからなる 第 I V 族元素、実 施 例 5 1 乃至 5 6の C u、 A 9、 A u からなる 第 I 族元素、実施 例 5 9乃至 6 6の B、 A I、 G a、 I n からなる 第 I I I 族元素、実 施 例 6 9乃至 7 2の 8 n、 P b からなる 第 I V 族元素、実 施 例 7 8 万至 7 8の P、 S b、 B i からなる 第 V 族元素、実 施 例 7 9 及 ひ 8 0 の 8 からなる 第 V I 族元素は、 高輝度を有する。

[0108]

実施例23万至28のV、Nb、Tのからなる第V族元素、実施例29万至34のCケ、Mo、Wからなる第VI族元素、実施例35及び36のReからなる第VII族元素、実施例37万至50のFe、Co、Iケ、Ni、Pd、Pt、Ruからなる第VIII族元素は、輝度の調整を行うことができる。

10

[0109]

20

[0110]

実施例1乃至80から、異なる元素が数百PPm濃度含まれている場合であっても、発光輝度、発光効率の大幅な低下を生じることなく、450mm~470mmの励起光源により、鮮やかな 色~赤色に発光する発光材料を提供することができる。

[0111]

また、温度特性は、発光素子の表面に該室化物蛍光体を設けたとき、窒化物蛍光体の発光が減衰せずに、高い発光特性を示しているかを表すものであり、温度特性が高いものほど安定であることを示している。実施例1乃至80は、35℃のとき、97~100%である。100℃のとき、95~100%である。200℃のとき、58~80%である。このことから、温度特性は、極めて良好である。

30

[0112]

特に、Bを数十~数百PPm添加したとき、CPを500PPm添加したときよりも、輝度が234.6%、量子効率が244.6%(Bを100PPm添加)、輝度が237.9%、量子効率が248.1%(Bを500PPm添加)と、発光効率の向上が図られた。実施例に記載していないが、Caの代わりに、Ba、SP、Ca-SF等を用いた場合でも、同様の効果が得られる。

40

[0118]

実施例1乃至80の窒化物蛍光体は、460nmの励起光源により励起させたとき609nm近傍にピーク波長を有する。

[0114]

実施例 3 の残光は 1 4 m S e c 、実施例 9 の残光は 1 8 m S e c 、実施例 1 1 の残光は 2 2 m S e c 、実施例 1 5 の残光は 1 8 m S e c 、実施例 1 7 の残光は 1 4 m S e c 、実施例 2 7 の残光は 1 8 m S e c 、実施例 2 7 の残光は 1 8 m S e c 、実施例 2 7 の残光は 1 0 m S e c 、実施例 3 9 の残光は 1 6 m S e c 、実施例 4 3 の残光は 1 2 m S e c 、実施例 5 9 の残光は 2 0 m S e c 、実施例 6 1 の残光は 2 2 m S e c などであった。このように、N a 、

[0115]

実施例1万至80の窒化物蛍光体の成分組成を分析したところ、添加量が500PPMのLi、Na、K、Rb、CS、M3、W、Cu、A3、Au、区n、Ga、In、Ge、Sn、Pb、P、Sb、Bi等は、100PPM以下の量しか残存していなかった。その他の異なる元素も、当初添加量よりも少ない量しか残存していなかった。例えば、500PPM添加したBは、400PPMしか残存していなかった。これは、焼成工程において、異なる元素が飛散したためであると考えられる。

[0116]

<発光装置1>

発光装置1は、赤味成分を付加した白色発光装置に関する。図1は、本発明に係る発光装置1を示す図である。図6は、本発明に係る発光装置1の色度座標を示す図である。

発光装置1は、サファイア基板1上にn型及びP型のGaN層の半導体層2が形成され、 該n型及びP型の半導体層2に電極3が設けられ、該電極3は、導電性ワイヤ14により リードフレーム13と導電接続されている。発光素子10の上部は、蛍光体11及びコー ティング部材12で覆われ、リードフレーム18、蛍光体11及びコーティング部材12 等の外周をモールド部材15で覆っている。半導体層2は、サファイア基板1上にn゚+ G an: 8i, n-AlGan: 8i, n-Gan, Galnn QWs, P-Gan: M タ、P-AIGaN:M分、P-GaN:M分の順に積層されている。該n ⁺ GaN:S i 層の一部はエッチングされて n 型電極が形成されている。該P - G a N : M 3 層上には 、P型電極が形成されている。リードフレーム13は、鉄入り銅を用いる。マウントリー ド130の上部には、発光素子10を積載するためのカップが設けられており、該カップ のほぼ中央部の底面に該発光素チ10がダイボンドされている。導電性ワイヤ14には、 金を用い、電極3と導電性ワイヤ14を導電接続するためのパンプ4には、Niメッキを 施す。蛍光体11には、実施例49の蛍光体とYAG系蛍光体とを退合する。コーティン グ部材12には、エポキシ樹脂と拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン及び前記蛍光体 11を所定の割合で混合したものを用いる。モールド部材15は、エポキシ樹脂を用いる 。この砲弾型の発光装置1は、モールド部材15の半径2~4mm、高さ約7~10mm の上部が半球の円筒型である。

[0118]

発光装置1 に電流を流すと、ほぼ460mmで励起する第1の発光スペクトルを有する青色発光素子10が発光し、この第1の発光スペクトルを、半導体層2を覆う蛍光体11が色調変換を行い、前記第1の発光スペクトルと異なる第2の発光スペクトルを有する。また、蛍光体11中に含有されているYAG系蛍光体は、第1の発光スペクトルにより、第3の発光スペクトルを示す。この第1、第2及び第3の発光スペクトルが互いに退色となり赤みを帯びた白色発光装置1を提供することができる。

[0119]

[0120]

発光装置 1 の蛍光体 1 1 の重量比は、コーティング部材: (Y-Gd-Al-O:Ce)の蛍光体: 実施例 1 5 の蛍光体 = 1 0:3.8:0.6である。一方、発光装置 2 の蛍光

10

20

30

40

体の重量比は、コーティング部材: (Y-Gd-Al-O:Ce)の蛍光体=10:3.6の重量比で混合している。

[0121]

本発明に係る発光装置1と、 青色発光素子及びY-Gd-AI-〇:Ceの蛍光体とを用いた発光装置とを比較する。 表2は、発光装置1と比較となる発光装置の測定結果を示す。 表2では、Y-Gd-AI-〇:Ceの蛍光体を、YAGと略記する。

[0122]

【表2】

	電流 IF (mA)	電圧 VF (V)	放射分析 Radiometric (mW)	光度測定 Photometric (Im)	ピーク波長 Peak (nm)	半値幅 FWHM (nm)	授波長 Dominant (nm)
青色LED	20	4.05	14.78	0.955	464,02	19,35	468.05
青色LED+YAG	20	3.75	9,59	3.042	463.47	150.73	568.85
青色LED+YAG+ 窓化物蛍光体	20	3,80	5.84	1.890	596.00	196.36	582.75

10

	色調 ×	色調 y	色温度 Tcp (K)	平均演色性 Ra	発光効率 (Im/W)
齊色LED	0.134	0.057	_	-	11.8
青色LED+YAG	0.348	0.367	4939	78	40.6
青色LED+YAG+ 空化物蛍光体	0.454	0,416	2828	76	24.9

20

[0123]

比較となる発光装置と比較して色調はほとんど変化していないが、演色性が改善されている。比較となる発光装置では、特殊演色評価数R9が不足していたが、発光装置1では、R9の改善が行われている。特殊演色評価数R9は、比較的彩度の高い赤色の標準色からの色ずれを測定した値である。また、他の特殊演色評価数R8、R10等もより100%に近い値に改善されている。ランプ効率は、高い数値を示している。

30

[0124]

40

[0125]

<発光装置2>

図7は、本発明に係る発光装置2を示す図である。発光装置2は、表面実装タイプの発光装置である。該発光装置2に使用する発光素子101は、青色光励起の発光素子を使用するが、380~400nmの紫外光励起の発光素子も使用することができ、発光素子101は、これに限定されない。

[0126]

発光層としてピーク波長が青色領域にある460mmのImGAN系半導体層を有する発 光素子101を用いる。該発光素子101には、P型半導体層とハ型半導体層とが形成されており(図示しない)、該P型半導体層とハ型半導体層には、リード電極102へ連結

される導電性ワイヤ104が形成されている。リード電極102の外周を覆うように絶縁 封止材103が形成され、短絡を防止している。発光素子101の上方には、パッケージ 105の上部にあるリッド106から延びる透光性の窓部107が設けられている。該透 光性の窓部107の内面には、本発明に係る蛍光体108及びコーティング部材109の 均一混合物がほぼ全面に塗布されている。発光装置1では、実施例1の蛍光体を使用する 。パッケージ105は、角部がとれた一辺が8mm~12mmの正方形である。

[0127]

発光素子101で青色に発光した発光スペクトルは、反射板で反射した間接的な発光スペクトルと、発光素子101から直接射出された発光スペクトルとが、本発明の蛍光体108に照射され、白色に発光する蛍光体となる。

[0128]

以上のようにして形成された発光装置を用いて白色LEDランプを形成すると、 歩留まりは99%である。 このように、本発明である発光ダイオードを使用することで、 量産性良く発光装置を生産でき、 信頼性が高く且っ色調ムラの少ない発光装置を提供することができる。

[0129]

<発光装置3>

図8は、本発明に係るキャップタイプの発光装置3を示す図である。

[0130]

発光装置1 における部材と同一の部材には同一の符号を付して、その説明を省略する。 【0181】 20

30

10

発光装置3は、発光装置1のモールド部材15の表面に、蛍光体(図示しない)を分散さ せた光透過性樹脂からなるキャップ16を被せることにより構成される。キャップ16は 、 蛍光体を光透過性樹脂に均一に分散させている。この蛍光体を含有する光透過性樹脂を 、発光装置1のモールド部材15の形状に 合する形状に成形している。または、所定の 型枠内に蛍光体を含有する光透過性樹脂を入れた後、発光装置1を該型枠内に押し込み、 成型する製造方法も可能である。キャップ16の光透過性樹脂の具体的材料としては、工 ポキシ樹脂、ユリア樹脂、シリコーン樹脂などの温度特性、耐候性に優れた透明樹脂、シ リカソル、ガラス、無機パインダーなどが用いられる。上記の他、メラミン樹脂、フェノ ール樹脂等の熱硬化性樹脂を使用することができる。また、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリ塩化ピニル、ポリスチレン等の熱可塑性樹脂、スチレン-プタプエンプロック共 重合体、セグメント化ポリウレタン等の熱可塑性ゴム等も使用することができる。また、 蛍光体と共に拡散剤、チタン酸パリウム、酸化チタン、酸化アルミニウムなどを含有させ ても良い。また、光安定化削や着色削を含有させても良い。キャップ16に使用される蛍 光体は、実施例15を使用する。マウントリード18ののカップ内に用いられる蛍光体1 1は、実施例15を用いる。しかし、キャップ16に蛍光体を用いるため、マウントリー ド18ののカップ内は、コーティング部材12のみでもよい。

[0132]

このように構成された発光装置は、発光素子10から放出された光の一部は、キャップ16を通過する際に、実施例43の蛍光体により波長変換される。かかる波長変換された光と、蛍光体により波長変換されなかった青色系の光とが混合され、結果として、キャップ16の表面からは、白色系の光が外部へ放出される。

[0133]

【発明の効果】

以上のことがら、本発明は、青色発光素子等と組み合わせて使用する黄から赤領域に発光スペクトルを有する窒化物蛍光体を提供することができる。窒化物蛍光体を用いて、発光効率の良好なやや赤みを帯びた暖色系の白色発光装置を提供することができる。

[0134]

また、本発明は、蛍光体の輝度を低下させる元素、及び、蛍光体の輝度を向上させる元素を特定することができた。これにより、坩堝、焼成炉の材質の最適化を図ることができ、

(28) 輝度の高い蛍光体を提供することができる。 [0135]また、粒径を所定の範囲に制御された窒化物蛍光体を提供することができる。 [0136] さらに、発光特性、耐久性の向上が図られた窒化物蛍光体を提供することができるという 極めて重要な技術的意義を有する。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明に係る発光装置1を示す図である。 【図2】本発明に係る窒化物蛍光体の製造方法を示す図である。 【図3】実施例60の窒化物蛍光体をEX=460nmで励起したときの発光スペクトル を示す図である。 【図4】実施例60の蛍光体の励起スペクトルを示す図である。 【図5】実施例60の蛍光体の反射スペクトルを示す図である。 【図6】本発明に係る発光装置1の色度座標を示す図である。 【図7】本発明に係る発光装置2を示す図である。 【図8】本発明に係るキャップタイプの発光装置3を示す図である。 【符号の説明】 P 1 原料のCaを粉砕する。 原料のCのを窒素雰囲気中で窒化する。 P 2 20 P 3 Cのの窒化物を粉砕する。 原料のSiを粉砕する。 P 4 P 5 原料のSiを窒素雰囲気中で窒化する。 Siの窒化物を粉砕する。 P 6 Euの化合物Eu2Ogに、Bの化合物HgBOgを湿式混合する。 P 7 Euの化合物Eu2Ogと、Bの化合物HgBOgとの混合物を、酸化雰囲気中 P 8 で焼成する。 EuとBの混合物を粉砕する。 P 9 Cのの窒化物、Siの窒化物、EuとBとの退合物を退合する。 P 1 0 Caの窒化物、Siの窒化物、EuとBとの混合物をアンモニア雰囲気中で、 P 1 1 30 焼成する。 P12 Bが添加されたCa2Si5N8:Euで表される蛍光体。 基 板 半導体層 2 3 電 桭 パンプ 発光素子 1 0 蛍光体 1 1 1 2 コーティング部材 リードフレーム 1 3 40 13a マウントリード インナーリード 1 3 b 1 4 導電性ワイヤ モールド部材 1 5 発光素子 1 0 1 リード電極 1 0 2

絕緣封止材

パッケージ

リッド

窓部

導電性ワイヤ

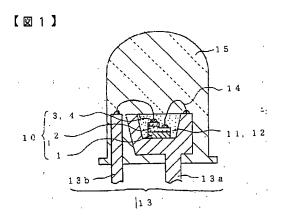
1 0 3 1 0 4

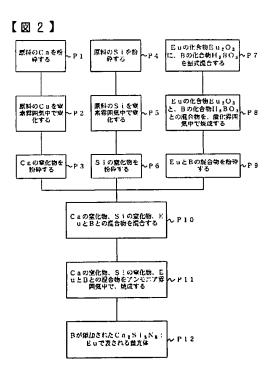
1 0 5

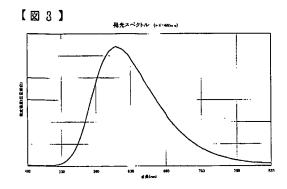
106

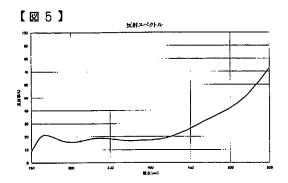
1 0 7

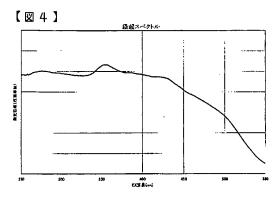
1 0 8 蛍光体1 0 9 コーティング部材

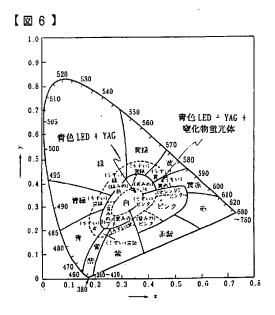


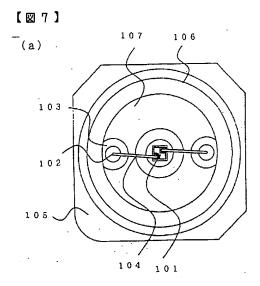


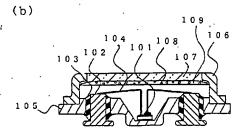




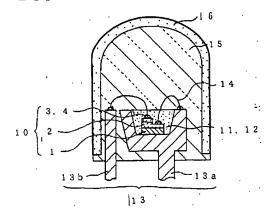








[8]



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

H01L 33/00

FΙ

テーマコード(参考)

C09K 11/65 CPM

CPP C09K 11/66

C09K 11/80

H01L 33/00

Ν

Fターム(参考) 4H001 CA04 CA05 CF02 XA06 XA07 XA08 XA12 XA13 XA14 XA20

XA30 XA31 XA32 XA38 XA39 XA56 XA64 YA00 YA03 YA05

YA11 YA13 YA15 YA19 YA22 YA23 YA24 YA26 YA27 YA28 YA29 YA31 YA37 YA39 YA40 YA41 YA42 YA44 YA46 YA47

YA49 YA50 YA51 YA55 YA58 YA63 YA72 YA73 YA74 YA75

YA76 YA78 YA79 YA82 YA83

5F041 AA03 AA11 AA44 CA05 CA34 CA40 CA46 DA18 DA19 DB01

DB09 EE25 FF01 FF11